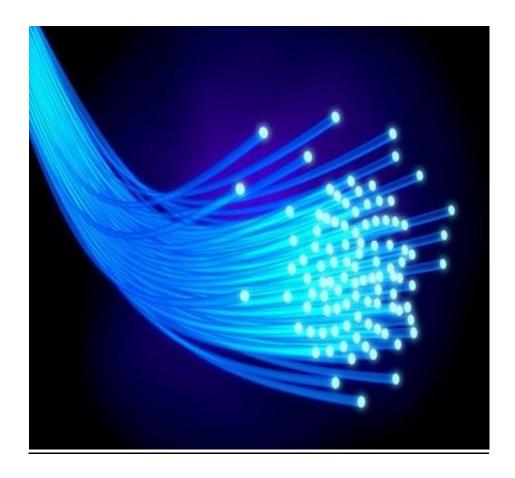
Οπτικές Επικοινωνίες

Προαιρετικά Θέματα 2ου κεφαλαίου



Διδάσκων: Εμμανουήλ Κοιεζής

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Ηλίας Χουσοβέργης

Α.Ε.Μ. Φοιτητή: 8009

Email Φοιτητή: <u>iliachry@ece.auth.gr</u>

(α) Για τον προσδιορισμό του μέγιστου πάχους του στρώματος Si πάνω από το οποίο ο ασυμμετρικός SOI κυματοδηγός γίνεται πολύρυθμος θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω script:

```
1 -
       wavelength1=1.55;
       wavelength2=1.31;
     n1=3.45;
       n2=1.45:
5 -
     n3=1.34;
 6 -
       flag1=true;
7 -
      flag2=true;
8 - for h = 0.2:0.0001:0.35
9 -
           [neff TE,neff TM]=APDWG(wavelength2,h,n1,n2,n3);
           if length(neff TE)>1 && flag1==true
10 -
11 -
               Hmax TE = h;
12 -
               flag1=false;
           end
13 -
14 -
           if length(neff TM)>1 && flag2==true
15 -
               Hmax TM = h;
16 -
               flag2=false;
17 -
           end
18
19 -
      ∟end
20
```

Στο παραπάνω script, αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιήσουμε το APDWG.m αρχείο όπου μπορεί να υπολογίσει τους ενεργούς δείκτες διάθλασης για τους οδηγούμενους ΤΕ και ΤΜ ρυθμούς δεδομένου του μήκους κύματος, του πάχους h του στρώματος και των δεικτών διάθλασης σε κάθε διαφορετικό στρώμα. Οπότε, δίνοντας διαφορετικό h κάθε φορά μπορούμε να βρούμε το σημείο στο οποίο ο SOI κυματοδηγός ξεκινάει να γίνεται πολύρυθμος.

Το script εκτελέστηκε μερικές φορές για να βρεθεί η περιοχή που έχουμε διέγερση δεύτερου ουθμού, και ύστερα αυξήθηκε η ακρίβεια (δεκαδικά ψηφία) της λύσης μέσω του for loop.

Το script εκτελέστηκε 2 φορές, μία για τα 1550 nm και μία για τα 1310 nm.

Τα τέσσερα ζητούμενα πάχη δίνονται στον πίνακα στην συνέχεια:

Μήκος κύματος(nm)	Hmax (nm) ΤΕ ουθμού	Hmax (nm) TM ουθμού
1550	261.4	315.8
1310	220.9	266.9

(β) Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου πάχους του στρώματος Si κάτω από το οποίο το ποσοστό ισχύος του stray-light γίνεται μεγαλύτερο από -70 dB του συνολικά οδηγούμενου θα χρησιμοποιήσουμε μία προσέγγιση του προβλήματος. Θα θεωρήσουμε ότι το υπόστρωμα SiO2 δεν είναι πεπερασμένου πάχους. Θα υπολογίζουμε το ποσοστό της ισχύος στην νοητή διαχωριστική γραμμή (όπου τελειώνει το υπόστρωμα) για διαφορετικό πάχος h του στρώματος Si με ένα for loop και πάλι.

Ο κώδικας που προσθέσαμε στην APDWG (για τους ΤΕ ρυθμούς) δίνεται στην συνέχεια:

```
Ey TE = NaN * zeros( Nmodes TE , length(x) );
for kkm = 1 : Nmodes_TE
    neff = neff TE(kkm);
    k1 = k0 * sqrt( n1^2 - neff^2 );
    k2 = k0 * sqrt(neff^2 - n2^2);
    k3 = k0 * sqrt(neff^2 - n3^2);
    phi = atan(k3 / k1);
    A1 = 1;
   A2 = A1 * cos(phi);
   A3 = A1 * cos(k1*h - phi);
    Ey TE( kkm , is1 ) = A1 * cos( k1 * x(is1) - phi );
    Ey TE( kkm , is2 ) = A2 * exp( k2 * x(is2) );
    Ey_TE(kkm, is3) = A3 * exp(-k3 *(x(is3)-h));
    if(kkm==1)
        Ey1=0(y) (A1 .* cos( k1 * y - phi )).^2;
        Ey2=0(y) (A2 .* exp(k2 * y)).^2;
       Ey3=0(y) (A3 .* exp(-k3 *(y-h))).^2;
        P11=(1/n1) *integral(Ey1,0,h);
        P12=(1/n2)*integral(Ey2,-1.75,0);
       P13=(1/n3) *integral(Ey3,h,Inf);
        P2=(1/n2)*integral(Ey2,-Inf,-1.75);
        P(1)=10*log10(P2/(P11+P12+P13+P2));
    end
end
```

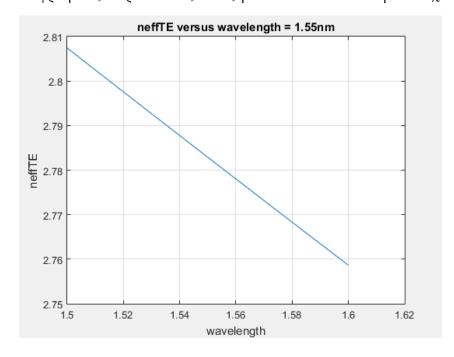
Τα τέσσερα ζητούμενα πάχη δίνονται στον πίνακα στην συνέχεια:

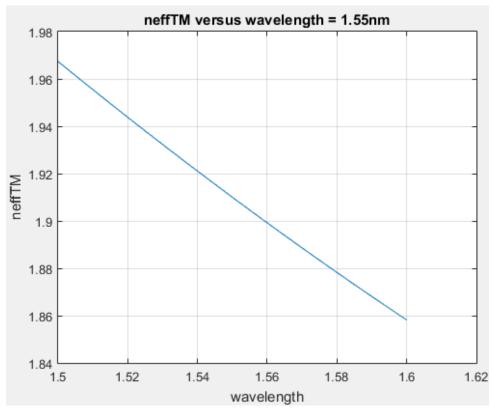
Μήκος κύματος(nm)	Hmin (nm) ΤΕ ουθμού	Hmin (nm) TM ουθμού
1550	62.6	193.6
1310	44.7	153

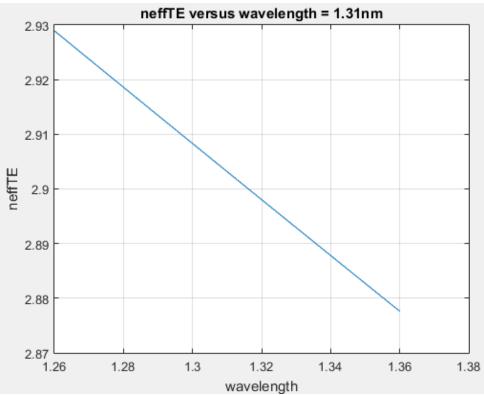
(γ) Για την επιλογή του πάχος που θα επιτρέπεται με την SIMOX τεχνική αλλά και θα πληροί όλες τις απαιτήσεις των δύο προηγουμένων ερωτημάτων ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε αρχικά την περιοχή τιμών του πάχους όπου πληρούνται οι απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα πινακάκια των δύο προηγουμένων ερωτημάτων η περιοχή τιμών είναι ανάμεσα στα 193 nm και τα 220 nm περίπου. Επειδή, ταυτόχρονα, το πάχος θα πρέπει να επιτρέπεται από την SIMOX τεχνική διαλέγουμε την τιμή 210 nm που είναι και περίπου στο μέσο της περιοχής τιμών. Το script δίνεται στην συνέχεια:

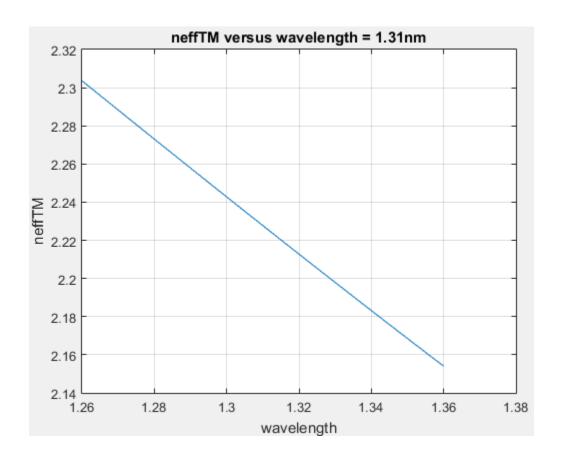
```
1 -
       wavelength=1.55;
       window=(wavelength-0.05):0.0001:(wavelength+0.05);
       neff TE = zeros(0,length(window));
       neff TM = zeros(0,length(window));
 5 - for i=1:length(window)
           [\sim, \sim, \sim, \text{ neff TE(i)}], neff TM(i)] = APDWG(window(i), 0.210, 3.45, 1.45, 1.34);
 6 -
 7 -
8 -
       plot(window,neff_TE)
9 -
       title(['neffTE versus wavelength = ' num2str(wavelength) 'nm'])
10 -
      xlabel('wavelength')
11 -
      ylabel('neffTE')
12 -
       grid on
13 -
       figure
14 -
      plot(window, neff TM)
      title(['neffTM versus wavelength = ' num2str(wavelength) 'nm'])
16 -
      xlabel('wavelength')
17 -
      ylabel('neffTM')
18 -
       grid on
```

Οι γραφικές παραστάσεις που ζητούνται δίνονται στην συνέχεια:









Μπορούμε να δούμε ότι ο ενεργός δείκτη διάθλασης των βασικών ΤΕ και ΤΜ ρυθμών μειώνεται γραμμικά σε σχέση με την αύξηση του μήκους κύματος στο παράθυρο των 100 nm και στις δύο περιοχές του μήκους κύματος.

(δ) Για τη επίλυση του συγκεκοιμένου ερωτήματος με την μέθοδο του ενεργού δείκτη (ΕΙΜ) χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω script:

```
1 - wavelength = 1.55;
2 - t = 0.05;
3 - H = 0.22;
4 - W = 0.32;
5 - [~,~,~, neff_TE1 , neff_TM1] = APDWG( wavelength , t ,3.45,1.45,1.34);
6 - [~,~,~, neff_TE2 , neff_TM2] = APDWG( wavelength , H ,3.45,1.45,1.34);
7 - [~,~,~, neff_TE3 , neff_TM3] = APDWG( wavelength , W ,neff_TE2,neff_TE1,neff_TE1);
```

Στην γοαμμή 5 υπολογίζουμε τους ενεργούς δείκτες διάθλασης των ΤΕ και των ΤΜ ρυθμών στην περιοχή όπου έχουμε πάχος t=0.05 μm. Στην γραμμή 6 υπολογίζουμε τους ενεργούς δείκτες διάθλασης των ΤΕ και των ΤΜ ρυθμών στην περιοχή όπου έχουμε πάχος H= 0.22 μm. Στην γραμμή 7 υπολογίζουμε τους ενεργούς δείκτες διάθλασης των ΤΕ και των ΤΜ ρυθμών στο κάθετο επίπεδο χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εντολών.

Για τον TM ουθμό παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, διότι στην περιοχή όπου το πάχος ήταν t=50 nm δεν οδηγείται. Για αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι ο TM ουθμός οδηγείται από το στρώμα SiO2, ο οποίος έχει δείκτη διαθλάσεως 1.45 .

Τα ζητούμενα neff δίνονται στον πίνακα στην συνέχεια:

Μήκος κύματος(nm)	ΤΕ - ΤΜ ουθμός	ΤΜ - ΤΕ ουθμός
1550	2.1951	1.6886
1310	2.4529 & 1.7859	2.0132

(α) Για την απόδειξη του πρώτου ερωτήματος έγιναν οι πράξεις που δίνονται στην συνέχεια:

$$V^2 \psi + i \delta_1 V^2 \psi = 0$$
. Avertua θ localized so or 220 προυύπες L:

 $\frac{\partial^2 \psi}{\partial p^2} + \frac{1}{p} \frac{\partial \psi}{\partial p} + \frac{1}{p^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial p^2} + (n^2 \kappa^2 - R^2)\psi = 0$.

He can be θοδο των χωριδοβένων βεταβλατών:

 $P^2 P'' + p P' + (Cn^2 \kappa_0^2 - R^2)p^2 - n^2)P = 0$. (1), $\Phi'' + m^2 \psi = 0$. (2).

H (2) έχει ως λίση την: $\Phi(\varphi) = A\cos(n\varphi)$, $n \in \mathbb{Z}$.

Για την (1), οτο εσωτεριώ του πρήνα έχω:

 $P^2 P'' + p P' + (Cn^2 \kappa_0^2 - R^2)p^2 - n^2)P = 0$, με λίση την $P(p) = A_2 J_m(\Psi_p)$

όπου $U = a\sqrt{\log n^2 - R^2}$.

Για την (1), οτο εδωτεριώ του πυρήνο έχω:

 $P^2 P'' + p P' + (Cn^2 \kappa_0^2 - R^2)p^2 - n^2 P = 0 = 0$

με λίση την $P(p) = B_2 IIm (W_p)$, όπου $W = a\sqrt{R^2 - \kappa_0 n_2}$.

Λόγω της αιθούς υνβιατωδή γισης η τελιώ λίση διαφορφώνεται ως ελής:

 $W = \left(A_2 J_m(Up/a)\right)$, $P = a$.

 $W = \left(A_4 J_m(Up/a)\right)$, $P = a$.

HE the anaithon the outextias the or p=a vai the outextias the Mapa xingou one y or p=a, Thouringel:

A, J, (U)-B, K, (W)=0.

 $A_1 \cup J_n(U) - B_1 = 0$

Tia va हेन्द्रा नेपंका क जर्जणमाव त्रष्ट्राहा va 107 प्रश:

Jn(U) = W Kn(W)

Jn(U) = W Kn(W)

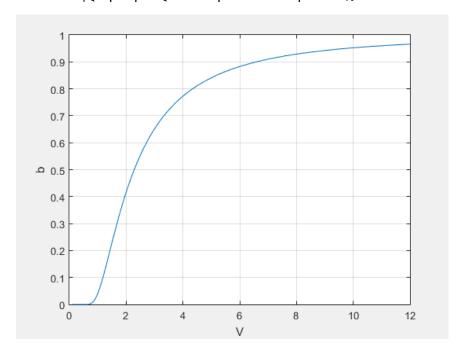
(β) Για την απόδειξη του δεύτερου ερωτήματος έγιναν οι πράξεις που δίνονται στην συνέχεια:

(γ) Για την αφιθμητική επίλυση της εξίσωσης του δεύτεφου εφωτήματος αφχικά χφειάστηκε μία συνάφτηση οπού το μόνο που θα πεφιλάμβανε θα ήταν η εξίσωση που θέλουμε να λυθεί. Αυτή δίνεται στην συνέχεια:

Στην συνέχεια χοησιμοποιήθηκε το παρακάτω script, το οποίο καλεί την συνάρτηση που δημιουργήθηκε προηγουμένως και την λύνει κάνοντας χρήση της συνάρτησης fsolve του matlab.

```
1 -
       V = 0.1:0.01:12;
       start = 0.95;
       c = zeros(0,length(V));
       options = optimoptions('fsolve');
       options = optimoptions(options, 'Tolfun', 10^(-15));
    - for i = 1:length(V)
7 -
           f = @(b) opt22c(b, V(i));
           c(i) = fsolve(f,start,options);
8 -
9 -
      ∟end
10 -
      plot(V,abs(c))
11 -
      xlabel('V')
12 -
      ylabel('b')
13 -
       grid on
```

Η γραφική παράσταση δίνεται στην συνέχεια:



(δ) Για την γραφική παράσταση της μεταβολής της ενεργού επιφάνειας Aeff για τον βασικό ρυθμό LP01 και όταν η παράμετρος V λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0.8, 2.4] χρησιμοποιήθηκε το script που δίνεται στην συνέχεια:

```
1 -
       syms r;
 2 -
       a=10;
 3 -
       V=0.8:0.01:2.4;
 4 -
       load('b.mat');
 5 -
      len=length(V);
 6 -
      int11(1:len)=0;
 7 -
      int12(1:len)=0;
 8 -
      int21(1:len)=0;
 9 -
       int22(1:len)=0;
10 -
      Aeff(1:len)=0;
11 - for i=1:len
12 -
           fun11 = \emptyset(r) ((besselj(0,(1/a)*V(i)*sqrt(1-b(i))*r)/besselj(0,V(i)*sqrt(1-b(i)))).^2).*r;
13 -
           fun12 = @(r) ((besselk(0,(1/a)*V(i)*sqrt(b(i))*r)/besselk(0,V(i)*sqrt(b(i)))).^2).*r;
14 -
           fun21 = @(r) ((besselj(0,(1/a)*V(i)*sqrt(1-b(i))*r)/besselj(0,V(i)*sqrt(1-b(i))).^4).*r;
15 -
           fun22 = @(r) ((besselk(0,(1/a)*V(i)*sqrt(b(i))*r)/besselk(0,V(i)*sqrt(b(i))).^4).*r;
16 -
           int11(i) = integral(fun11,0,a);
17 -
           int12(i) = integral(fun12,a,Inf);
18 -
           int21(i) = integral(fun21,0,a);
19 -
           int22(i) = integral(fun22,a,Inf);
20 -
           Aeff(i) = 2*pi*(int11(i) + int12(i))^2 / (int21(i) + int22(i)) / (pi*a^2);
21 -
22 -
      plot(V, Aeff)
23 -
       grid on
24 -
       xlabel('V')
25 -
       ylabel('Aeff')
```

Η γραφική παράσταση δίνεται στην συνέχεια:

